Requested Patent:

JP56142629A

Title:

VACUUM DEVICE:

Abstracted Patent

JP56142629;

Publication Date:

1981-11-07 ;

Inventor(s):

TSUMURA SUEO ;

Applicant(s):

NEC CORP:

Application Number:

JP19800046690 19800409;

Priority Number(s):

IPC Classification:

H01L21/205; H01L21/265; H01L21/285; H01L21/302; H01L21/31;

Equivalents:

ABSTRACT:

PURPOSE: To enable continuous treatment in high vacuum by forming a slit, through which semiconductor wafers can pass, to a block connecting several vacuum chambers, the degree of vacuum thereof is increased by stages.

CONSTITUTION:A slit 3A in an extent that semiconductor wafers 1 can pass is made up to a block 3 conneting several vacuum chambers, which have exhaust pipes and the degree of vacuum thereof is increased by stages, and the semiconductor wafers 1 are successively transported to the next vacuum chambers by means of O ring belts 2 (4 are O ring belt holes). Thus, the wafers 1 can continuously be sent into high vacuum chambers from atmospheric pressure without using vacuum valves.

(9) 日本国特許庁 (JP)

卯特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭56—142629

Int. Cl.	識別記号	庁内整理番号	❸公開 昭和56年(1981)11月7日
H 01 L 21/205		7739—5 F	
21/265		6851—5 F	発明の数 1
21/285	•	76385 F	審査請求 未請求
21/302		6741-5F	
21/31		773 9 —5 F	(全 3 頁)
			•

②真空装置

创特

顧 昭55-46690

②出 額.昭55(1980)4月9日

@発 明 者 津村末朗

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

の出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

四代 理 人 弁理士 菅野中

明 網 看

1.発明の名称

真空装置

2. 停許請求の範囲

(1) 段階的に真空度を高めた幾つかの真空室と、その各真空室を脱気する排気管と、各真空室を混乱するが気管と、各真空室を連結するブロックとからなり、ブロックに半導体ウエハースが通過出来る程度のスリットを設け、半導体ウエハースをスリットを通して一の真空室から他の真空室へ移送するのリングペルトをブロックと真空室とに載つて配致してなる真空装置。

3.発明の静綴な説明

半導体ウェハースの生産プロセスにかいて、 近年、真空中で処理を行う工程が多くなつている。たとえば、蒸着、スペッタリング、プラズマロVDイオン注入等である。 ところが、大気中のウェハースを処理室である。 る真空室内に入れるに当つて、ほとんどのもの はパッチ処理によつて行なわれ、又、キャリアックャャリアでないためにウエハースハンドリングが非常に頻雑であつた。

本発明は、複雑な機構を用いずにキャリアか ちゥエハースを一枚ずつ高真空室に送り込み再 び大気中のキャリアに連続的に戻すことの出来 る真空装置を提供するものである。

以下本発明の実施例を関によつて説明する。 第1図において、1はウェハース、2はウェハースを乗せて搬送するための0リングベルトで ある。故ベルト2は、庭方体プロック3にあけ られた孔4を通して該プロック3及び真空室7 にまたがつて配数され、プロック3にはウェハース1が通るととができる程度の大きさのスリット3Aが阅口されている。

第2図はローダ例又はアンローダ側のキャリア 6からウェハーが出て行き又逆にキャリア 6 に入つてくる部分を示す。図中7は真空室の一つを示し、8 はその排気音である。5 はキャリアに1 ピッチブつ上下送りを与えるエレベータ

である。

館3 図は本発明の金体のシステムの一実施例を示すものである。キャリア 6 から出たクエハースは 71 ~ 74 ~ 71 までの各実空窟を通りキャリア 6 に入る。

各真空宮はそれぞれ排気質8 K設けたパルブ 9 を介して下配の真空変に排気されている。

室 71 は 10 Torr

室 7s は 10-itorr

全 74 は 10 - 3Torr

室 74 は 10- *Torr. (ウェヘー処理室)

各家はそれぞれの実空度に応じた複額のポンプで脱気されている。

本発明において、各実空室の間にはいつさい パルブがなく真空室の両端には、第1図に示す スリットを持つたプロック3で連結されている。 したがつて、各室の真空度は所要の値に保持 されているかどうかが問題となる。

プロック3のコンダクタンスCを計算すると 次のと知りである。

ととで、相称する真空室の真空度を Pn「Torr」 Pn+1「Torr」とすると n 番目の室から n+1番目 の室に使入する(今 Pn>Pn+1 とする) ガス量は

Qin = Pn·C である。

Pn+1 室に付いているポンプの実効排気スピードを n+18eとすれば

n+1⁸e · Pn+1 = Qin = Pn ・ C でメランスする。

Pn+1 × 100 = Pn とすれば

 $n+1^{8} = \frac{P_{n}}{P_{n+1}} \cdot C = 100 \cdot C$ (4) (1)、(2)、(3)式の結果からCは殺大でも0.6 「4/8」であるから

n+1⁸ m = 100 × 0.6 = 60 [L/8]
となり、各室には 60 [L/8] 以上の排気スピードのポンプをつないでおけば、第 3 週のシステムにより充分に各室の真空度が保たれることが 利る。

す なわち、 本発明の実施例では第 1 図に示す ブロック 3 のスリットの高さ a = 1 「 ma 」 スリットの巾 b = 100 「ma」 プロックの扱さ

p#1 = 10「Torr」とすると a/b=(.1/0.01 の時

粘性液で KR≒0.02

分子院で xg = 2 であるから
v = 0.26·0.02·0.1²×10² 1000+10
= 0.26「L/B」 (760Torr(AIM)~10Torr)
同様に

 $= 0.0026 \lceil L/8 \rfloor (10 \text{Torr} \sim 10^{-1} \text{Torr}) (1)$ $= 0.000026 \lceil L/8 \rfloor (10^{-1} \text{Torr} \sim 10^{-2} \text{Torr}) (2)$ $= 0.000026 \lceil L/8 \rfloor (10^{-1} \times 10^{2} \times 10^{-2} \times$

と= 100 「mm」とし、各実空室にはそれぞれの真空度に応じた種類の実効排気スピード 60 「ℓ/8」以上の排気系及びポンプを設ける事により図3に示す様なシステムで両端網放でウェハースを大気圧から 10⁻⁸ 「Torr」に放圧し、又逆に大気圧まで連続的に通過させるととが可能となつた。

以上のように本発明によれば、何ら真空パルプを用いる事なくウエハースを大気圧から高真空室内に連続的に送り込み、又逆に高真空室内より連続的に大気中にウエハースを取出す事ができ、全行程をロリングベルトに乗せてキャリアンウキャリアで処理を行なうことができる。

な♪、 第3 図のシステムは一実施例であり、 Po+1 = 10⁻² · P_n とすれば、

処理室の真空度 10⁻⁵「Torr」 にとどまらす、 さらに、高真空(実際はポンプその他の関係で 10⁻⁷「Torr」 祖厳)に上げることも可能である。

4.図面の簡単な説明

第1図は各真空窟連結プロックの斜視図、第 2図はロード、アンロード爆弾を示す側面図、

競3図は全システム系統図である。

- 1 …ウエヘース
- 2 … 0 リングペルト
- 3 … ブロック
- 34 … スリット
- 4 …0リングペルト穴
- 5 …キャリアエレペータ
- 6 …キャリア
- 7 … 71 ~ 74 英空室
- 8 … 游気管
- 9 -- ペルブ

特許出願人 日本電気株式会社

代理人 弁理士 劳 野 中

